

主要指标:

- 频率范围: 8GHz~12GHz
- 功率增益: 21dB
- 饱和输出功率: 100W
- 功率附加效率: 35% (typ.)
- 外形尺寸: 24.9mm×24.0mm×7.8mm

产品简介:

HXNM42008是一种 X 波段 GaN 宽带功率放大器模块，频率范围覆盖 8GHz~12GHz，饱和输出功率大于 100W，功率增益大于 21dB。

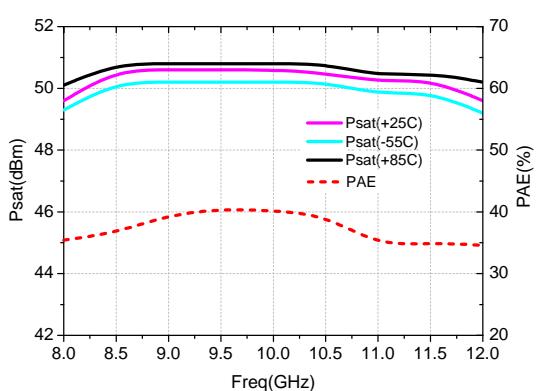
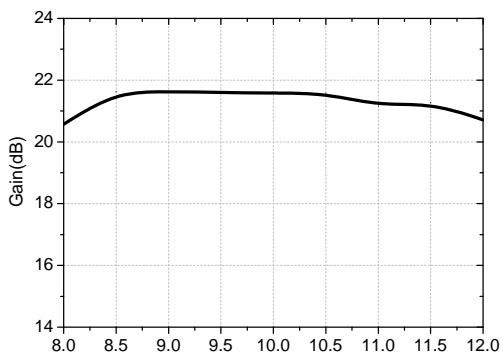
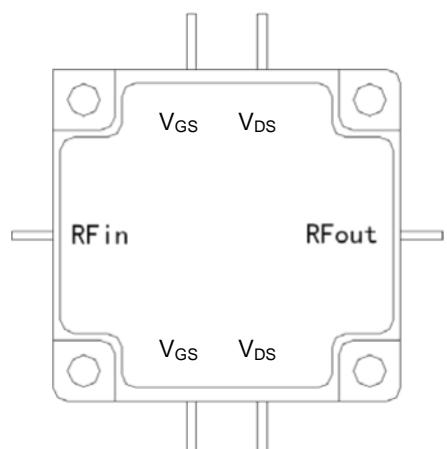
电参数 (T_c= +25°C, V_{DS}= +30V, V_{GS}= -2V)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	8~12			GHz
P _{sat}	49.5	50	-	dBm
功率增益	21	-	-	dB
增益平坦度	-	±0.6	-	dB
附加效率	33	35	-	%
输入驻波	-	-	2.0	-
二次谐波	-	-	-30	dBc
杂散抑制	-	-	-60	dBc
工作电流	10A/30V (峰值)			
外形尺寸	24.9mm×24.0mm×7.8mm			

极限参数

漏源正偏压	34V
栅源负偏压	-3V
最高输入功率	+32dBm
储存温度	-65°C ~ +150°C
使用温度(T _c)	-55°C ~ +85°C

注: 输入信号脉宽 1ms, 占空比 10%, 功率 29dBm。

典型曲线**饱和输出功率/效率 vs. 频率****功率增益 vs. 频率****引出端排列图**

引脚号	符 号	功 能
2,6	V _{GS}	栅源电源端口
1	RFin	射频信号输入端
4	RFout	射频信号输出端
3、5	V _{DS}	漏源电源端口

使用方法和注意事项:

使用时将器件紧贴盒体底部用螺钉固定，保证器件良好散热；加电时先加栅压后加漏压，紧靠栅引脚加一个滤波钽电容，容值 10~33uF；输入、输出法兰可拆卸；特别提示，该器件为静电敏感器件，操作时请严防静电。

外形尺寸：

